

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-158697

(43)Date of publication of application : 12.06.2001

(51)Int.Cl.

C30B 29/36
H01L 21/205
H01L 21/324

(21)Application number : 11-338391

(71)Applicant : TOYOTA CENTRAL RES & DEV LAB INC
DENSO CORP

(22)Date of filing : 29.11.1999

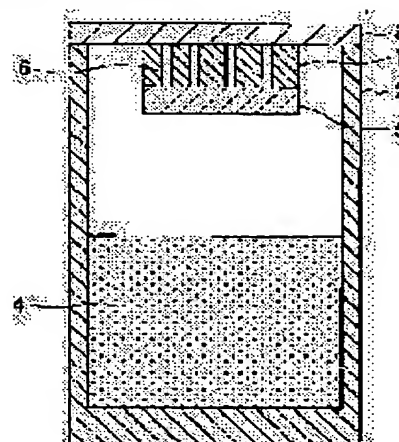
(72)Inventor : OKAMOTO ATSUHITO
SUGIYAMA NAOHIRO
TANI TOSHIHIKO
KAMIYA NOBUO
HIROSE FUSAO

(54) SILICON CARBIDE SINGLE CRYSTAL AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To seal micropipe defects present in a silicon carbide single crystal in the inside of the silicon carbide single crystal.

SOLUTION: A crystal substrate 1 is prepared. Opening parts of the micropipe defects 6 are coated with a coating material 5. When the crystal substrate is heat-treated, the micropipe defects 6 present in the crystal substrate 1 can be sealed in the inside of the crystal substrate 1. Then, the coating material 5 is removed, the silicon carbide single crystal is grown by using the crystal substrate 1 as a seed crystal. The grown silicon carbide single crystal is reused as the crystal substrate 1. The crystal substrate 1 is coated with the coating material 5 and the sealing process by the heat treatment is repeated. When the silicon carbide single crystal is grown by using the crystal substrate having sealed the micropipe defects as the seed crystal, since the micropipe defects are not succeeded in the sealed part, the micropipe defects can be sealed more by carrying out the sealing process reusing the grown silicon carbide single crystal as the crystal substrate 1.



- 1: 炭化珪単結晶 (基板結晶)
- 2: むつば
- 3: 基板
- 4: 炭化珪
- 5: 被覆材料
- 6: マイクロパイプ欠陥
- 7: 閉塞孔

*** NOTICES ***

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1]A process of preparing a substrate crystal (1) which consists of silicon carbide monocrystal which has micropipe defects (6), A coating process which covers with covering material (5) at least one side of an opening of said micropipe defects formed in said substrate crystal, and by performing heat treatment, A blockade process of making said micropipe defects which exist in said substrate crystal blockading inside said substrate crystal, and making said at least some of micropipe defects into a blockade hole (7), After said some of micropipe defects remove said covering material of said substrate crystal used as a blockade hole, Said silicon carbide monocrystal grown up is again used as a substrate crystal including a growing process into which silicon carbide monocrystal is grown up by using this substrate crystal as a seed crystal, A manufacturing method of silicon carbide monocrystal making micropipe defects which repeat said coating process, said blockade process, and a growing process once [at least], and are formed in this substrate crystal blockade.

[Claim 2]After removing said covering material of said substrate crystal which was provided with the following and in which said micropipe defects became a blockade hole, A manufacturing method of silicon carbide monocrystal which repeats again a process of performing said coating process and said blockade process, once [at least], and is characterized by making micropipe defects currently formed in said substrate crystal blockade.

A process of preparing a substrate crystal (1) which consists of silicon carbide monocrystal which has micropipe defects (6).

A coating process which covers with covering material (5) at least one side of an opening of micropipe defects formed in said substrate crystal.

A blockade process of making said micropipe defects which exist in said substrate crystal by heat-treating blockading inside said substrate crystal, and making said at least some of micropipe defects into a blockade hole (7).

[Claim 3]A manufacturing method of the silicon carbide monocrystal according to claim 1 or 2 characterized by said heat treatment temperature being 2200-2500 ** in said blockade process.

[Claim 4]A manufacturing method of silicon carbide monocrystal of any one statement of claim 1 thru/or 3 said covering material covering C (000-1) side of said substrate crystals in said coating process.

[Claim 5]A manufacturing method of silicon carbide monocrystal of any one statement of claim 1 thru/or 4 including a process of arranging a surface-protection film for preventing heat etching of this covering material being carried out on the surface of said covering material in said coating process.

[Claim 6]A manufacturing method of silicon carbide monocrystal of any one statement of claim 1 thru/or 5 performing said heat treatment where said substrate crystal covered in said blockade process by said covering material is covered with carbonization prevention material.

[Claim 7]A manufacturing method of silicon carbide monocrystal of any one statement of claim 1 thru/or 6 using silicon carbide monocrystal of 4H polymorphism as said substrate crystal.

[Claim 8]A manufacturing method of silicon carbide monocrystal growing up silicon carbide monocrystal on this seed crystal by using as a seed crystal a substrate crystal which has the blockade hole which was manufactured using a silicon-carbide-monocrystal manufacturing method of any one statement of claim 1 thru/or 7, and by which micropipe defects were blockaded.

[Translation done.]

* NOTICES *

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.*** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention]This invention relates to the silicon carbide monocrystal in which the manufacturing method and micropipe defects of the silicon carbide (SiC) single crystal in which micropipe defects were blocked were blocked.

[0002]

[Description of the Prior Art]When manufacturing a SiC single crystal by the improvement Rayleigh method (the sublimating method) by using a SiC single crystal as a seed crystal, the hollow breakthrough (diameter sub mum thru/or several micrometers) called micropipe defects (hollow penetration defect) develops along an abbreviated growth direction, and is inherent in a growth crystal. Since micropipe defects have an adverse effect on the electrical property of a device, the SiC single crystal with micropipe defects does not fit the substrate for device formation. For this reason, it has been an important technical problem to reduce micropipe defects.

[0003]As a reducing method of micropipe defects, the method shown in a U.S. Pat. No. 5,679,153 specification, the patent No. 2804860 gazette, or the patent No. 2876122 gazette is proposed.

[0004]The method shown in a U.S. Pat. No. 5,679,153 specification, If crystal growth is carried out by the liquid phase epitaxy method using SiC melting in silicon, It uses that micropipe defects are blocked in the middle of epitaxial growth, The epitaxial layer (defect density: $0-50\text{-cm}^{-2}$) by which micropipe defects were reduced on the seed crystal (defect density: $50-400\text{-cm}^{-2}$) which has micropipe defects is grown up.

[0005]The method shown in the patent No. 2804860 gazette, By using a field vertical to a field as a grown surface (0001) of a seed crystal, the single crystal in which a hexagon etch pit is not observed at all, i.e., the single crystal in which micropipe defects do not exist, is grown up on a seed crystal on the occasion of alkali etching.

[0006]The method shown in the patent No. 2876122 gazette, On the surface of alpha(hexagonal)-SiC single crystal substrate (seed crystal), by the thermochemical vapor-depositing (CVD) method, membrane formation of the polycrystal membrane of beta(cubic)-SiC or alpha-SiC, By repeating heat treatment to the complex obtained by it two or more times, By carrying out orientation (a certain kind of solid phase epitaxial growth) of beta-SiC of two or more layers, or the alpha-SiC polycrystal film to the same direction as the crystal axis of alpha-SiC single crystal substrate (seed crystal), The high quality which does not have crystal defects, such as micropipe defects, on a seed crystal, and the single crystal SiC of high thickness are grown up.

[0007]

[Problem(s) to be Solved by the Invention]The three above-mentioned methods both grow up a new single crystal on a seed crystal, and he is trying to reduce micropipe-defects density in the growth phase.

[0008]For this reason, in the 1st method, in order to obtain a portion without micropipe defects, a not less than 20-75-micrometer epitaxial layer must be grown up by a liquid phase epitaxy method, and there is a problem that micropipe defects still exist below at that range. If single crystal growth is again performed by the sublimating method by using as a seed crystal the epitaxial layer formed in this way, Since the portion by which micropipe defects were blocked is thin, the blocked portion may sublime, the opening of micropipe defects may be produced again, and the problem of being difficult also has sample adjustment of a seed crystal and rationalization of the sublimating method growing condition.

[0009]On the other hand, in the 2nd method, although it is effective at the point which controls generating of micropipe defects, since a new stacking fault is introduced into the single crystal grown up, anisotropy is produced in the electrical property of a substrate and there is a problem that it is not suitable as a substrate for electron devices.

[0010]On the other hand, in the 3rd method, in order to form beta-SiC or alpha-SiC polycrystal film in the surface of alpha-SiC single crystal substrate (seed crystal) with a CVD method, the SiC complex which was inherent in the grain boundary is obtained. If this complex is heat-treated and solid phase epitaxial growth is carried out on a seed crystal, the microcrystal in beta-SiC or alpha-SiC polycrystal film carries out derivation growth (over growth), and the clear grain boundaries decrease in number with heat treatment, but. There is a fear of the crystal defect which made the cause the internal strain in the above-mentioned grain boundary, the crystal grain boundary accompanying an uneven phase transformation, etc. being introduced. Since such a defect serves as a source of a trap of a career, there is a problem that it is not suitable as a substrate for electron devices.

[0011]This invention is made in light of the above-mentioned problems, and generating of micropipe defects and succession are not controlled in a new growth phase, but it aims at enabling it to make the micropipe defects which

exist in silicon carbide monocrystal blockade inside silicon carbide monocrystal.

[0012]

[Means for Solving the Problem] In order to attain the above-mentioned purpose, in the invention according to claim 1. A process of preparing a substrate crystal (1) which consists of silicon carbide monocrystal which has micropipe defects (6), A coating process which covers with covering material (5) at least one side of an opening of micropipe defects formed in a substrate crystal, and by performing heat treatment, A blockade process of making micropipe defects which exist in a substrate crystal blockading inside a substrate crystal, and making at least some micropipe defects into a blockade hole (7), After some micropipe defects remove covering material of a substrate crystal used as a blockade hole, silicon carbide monocrystal grown up is again used as a substrate crystal including a growing process into which silicon carbide monocrystal is grown up by using this substrate crystal as a seed crystal, A coating process, a blockade process, and a growing process are repeated once [at least], and it is characterized by making micropipe defects currently formed in a substrate crystal blockade.

[0013] Thus, if it heat-treats by covering a substrate crystal which consists of silicon carbide monocrystal with covering material, micropipe defects can be made to blockade inside a substrate crystal. And when growing up silicon carbide monocrystal by using as a seed crystal a substrate crystal which micropipe defects blockaded. Since micropipe defects are not inherited by silicon carbide monocrystal about a blockaded portion, silicon carbide monocrystal grown up is again used for a substrate crystal, and if small and a coating process, a blockade process, and a growing process will be repeated once, micropipe defects can be blockaded further. As especially shown in claim 7, since micropipe defects are hard to be blockaded, silicon carbide monocrystal of 4H polymorphism becomes effective [performing a repetition blockade process].

[0014] A process of preparing a substrate crystal (1) which consists of silicon carbide monocrystal which has micropipe defects (6) in the invention according to claim 2, A coating process which covers with covering material (5) at least one side of an opening of micropipe defects formed in a substrate crystal, and by performing heat treatment, Micropipe defects which exist in a substrate crystal are made to blockade inside a substrate crystal, It has the blockade process of making at least some micropipe defects into a blockade hole (7), After micropipe defects remove covering material of a substrate crystal used as a blockade hole, a process of performing a coating process and a blockade process is repeated once [at least] again, and it is characterized by making micropipe defects currently formed in a substrate crystal blockade.

[0015] By thus, a thing performed by repeating a coating process and a blockade process after performing a blockade process of micropipe defects. Since an enveloping layer is formed in a place where activation energy for a blockade is low probable at the 2nd blockade process, micropipe defects which were not blockaded at the 1st blockade process can also blockade more micropipe defects.

[0016] As shown in claim 3, it is desirable for heat treatment temperature to be 2200-2500 ** in a blockade process. It is good for heat treatment temperature to be around 2400 ** more preferably.

[0017] In the invention according to claim 4, it is characterized by covering C (000-1) side of the substrate crystals with covering material by a coating process.

[0018] Since this (000-1) C side is a field into which it is easy to grow up silicon carbide monocrystal of 4H polymorphism, it is suitable by blockading micropipe defects in this field to grow up silicon carbide monocrystal of 4H polymorphism after a blockade.

[0019] In the invention according to claim 5, it is characterized by including a process of arranging a surface-protection film on the surface of covering material by a coating process.

[0020] Thus, by arranging a surface-protection film on the surface of covering material, while covering material heat-treats, it can prevent being removed by heat etching, and micropipe defects can be covered certainly.

[0021] In the invention according to claim 6, it is characterized by heat-treating, where a substrate crystal covered with covering material is covered with carbonization prevention material at a blockade process.

[0022] Thus, a substrate crystal can be prevented from being carbonized during heat treatment by covering a substrate crystal with carbonization prevention material. As this carbonization prevention material, gaseous phase raw materials, such as solid materials, such as powder containing SiC and Si, Silang, and propane, etc. are effective. These are effective in preventing heat etching of the covering material 5.

[0023] Numerals in a parenthesis of each above-mentioned means show a correspondence relation with a concrete means of a statement to an embodiment mentioned later.

[0024]

[Embodiment of the Invention] (A 1st embodiment) The embodiment shown in a figure is described hereafter.

[0025] The outline sectional view of the thermal treatment equipment used for blockading the micropipe defects 6 of the substrate crystal (silicon carbide monocrystal) 1 is shown in drawing 1.

[0026] The thermal treatment equipment is constituted by the wrap lid 3 in the opening of the crucible 2 in which the upper part carried out the opening, and the crucible 2. These crucibles 2 and the lid 3 comprise graphite.

[0027] In the crucible 2, the silicon carbide 4 used as the raw material for performing stably heat treatment for blockading the micropipe defects 6 with sufficient reproducibility is accommodated. When the substrate crystal 1 is supported on the lid 3 and the opening of the crucible 2 is covered by the lid 3, the placed opposite of the substrate crystal 1 is carried out to the silicon carbide 4. Hereafter, the mounting surface side is called mounting surface side surface among both the surfaces of the substrate crystal 1, and the opposite hand of a mounting surface is called non-mounting surface side surface.

[0028] Although it is not illustrating in drawing 1, the resistance heating element made from graphite is arranged at

the periphery of the crucible 2, and this resistance heating element can adjust the temperature of the substrate crystal 1, and the temperature of the silicon carbide 4 on the temperature in the crucible 2, and a concrete target. Although not illustrated, the crucible 2 is put in in the container which can adjust the pressure of atmosphere, and introduction of the inactive gas into the crucible 2, etc. and adjustment of ambient pressure power are possible for it.

[0029]What expanded the neighborhood of the substrate crystal 1 of drawing 1 is shown in drawing 2. As shown in drawing 2, at least one surface (this figure the non-mounting surface side) of the substrate crystal 1 is covered with the covering material 5. For example, he is trying to cover C (000-1) side of the substrate crystal 1 with the covering material 5. Since it is a crystal face into which 4H polymorphism is grown up stably, if such a C side (carbon side) blockades the micropipe defects 6 in C side, it is suitable to grow up the silicon carbide monocrystal of 4H polymorphism by using as a seed crystal the substrate blockaded after blockading.

[0030]This covering material 5 precedes heat treatment for the micropipe-defects blockade mentioned later. For example, it is made to deposit on the substrate crystal 1 beforehand by liquid phase epitaxy methods, such as vapor phase growth, such as a chemical-vacuum-deposition (CVD) method, a molecular beam epitaxy (MBE) method, weld slag vacuum deposition, and the sublimating method, and a liquid phase epitaxy (LPE) method.

[0031]Although both SiC of the same crystal form as the substrate crystal 1 and SiC of a different-species polymorphism are applicable to the covering material 5, when the material of the substrate crystal 1 is hexagonal form silicon carbide monocrystal, the cubic (3C polymorphism) silicon carbide epitaxial film is suitable.

[0032]As the covering material 5, in addition, an SiC polycrystal object, a SiC sintered compact, amorphous SiC, The complex of carbon materials (for example, black lead, a carbon nanotube, fullerene, etc.), the material containing silicon, and a carbon material and high-melting point substances (for example, tungsten, tungsten carbide, boron nitride, etc.) are also applicable.

[0033]In drawing 1 and drawing 2, although what is necessary is just to have covered at least one side of both the surfaces of the substrate crystal 1 with the covering material 5 although the non-mounting surface side surface of the substrate crystal 1 is covered with the covering material 5 and it is not necessary to be necessarily a non-mounting surface side surface, it is desirable that it is a non-mounting surface side surface. Although the covering material 5 may be made to form on the substrate crystal 1 in advance of heat treatment mentioned later, it may be made to form on the surface of the substrate crystal 1 into a heat treatment process.

[0034]As for this covering material 5, although it can be chosen in several micrometers - several millimeters, when the flexibility and the manufacturing cost of a heat treatment condition for a micropipe-defects blockade are taken into consideration, it is preferred to choose in several 10 micrometers - the range of 100 micrometers of numbers.

[0035]Although it is arbitrarily selectable also in the thickness of the substrate crystal 1, When it takes into consideration that the direction which thickened the substrate crystal 1 can form at once many things which do not have micropipe defects more, and that there is possibility of modification and breakage and the operativity in a manufacturing process has a difficulty if the substrate crystal 1 is still too thinner, it is desirable to be referred to as not less than at least 100 micrometers.

[0036]Heat treatment is performed after arranging the substrate crystal 1 constituted in this way in the thermal treatment equipment shown in drawing 1.

[0037]The temperature of the substrate crystal 1 is made to become the range of 1800-2500 ** as temperature conditions of heat treatment at this time. When especially the substrate crystal 1 is 4H polymorphism, it is considered as heat treatment temperature [relatively high temperature / method / usual / sublimating] so that it may become a range whose temperature of the substrate crystal 1 is 2200-2500 **. The reason made into such a temperature requirement is because there is a problem of being it harder to blockade the micropipe defects 6 to be low temperature than 2200 ** and there is a problem that the substrate crystal 1 carbonizes that it is an elevated temperature rather than 2500 **. By choosing such heat treatment temperature, gaseous phase diffusion of the composition atom of the substrate crystal 1, solid phase diffusion, and surface diffusion are promoted, and it becomes possible to raise blockade speed. As the example mentioned later showed, according to various experiments, the temperature of around 2400 ** was the heat treatment temperature which was most suitable for a micropipe-defects blockade.

[0038]And the above-mentioned conditions were heat-treated, using the thing of 6H polymorphism and 4H polymorphism for example as the substrate crystal 1. The situation after performing the blockade process of these micropipe defects 6 is shown in drawing 3. This figure shows the section after a micropipe-defects blockade process when the thing of 6H polymorphism is used as the substrate crystal 1.

[0039]As shown in this figure, when the thing of 6H polymorphism was used as the substrate crystal 1, all the micropipe defects 6 that had an opening on the surface of the substrate crystal 1 had become the blockade hole 7 of the surface of the substrate crystal 1 blockaded from one way at least.

[0040>About the mechanism by which the micropipe defects 6 are blockaded, it is guessed as follows.

[0041]It is thought that the micropipe defects 6 became a hollow breakthrough in order that the screw dislocation core which has a big Burgers vector might ease big elastic strain energy (F. C.Frank,Acta.Cryst.4 (1951) 497 reference).

[0042]The clogging phenomenon of the micropipe defects 6 is presumed that the phenomenon contrary to the mechanism of the above-mentioned micropipe defects 6 has occurred. The blockade inference model of the micropipe defects 6 is explained using drawing 4.

[0043]The case where the substrate crystal 1 including the micropipe defects 6 in which the 3C-SiC epitaxial film

was formed as the covering material 5 is installed in the lid 3 made from black lead is considered (drawing 4 (a)). If it arranges in the thermal treatment equipment shown in drawing 1 in this state and heat-treats on suitable temperature and pressure conditions, in order to maintain the equilibrium vapor pressure at that temperature, Steamy kinds, such as Si, SiC₂, and Si₂C, sublime like the arrow in a figure from the graphite of the circumference of the micropipe defects 6, a 3C-SiC epitaxial film, and a lid. (Drawing 4 (b)).

[0044]Then, in [although a reason still is not clear now] the interface with the lid 3 made from black lead and the interface with covering material from the transmission-electron-microscopic-observation result of a blockade part, The micropipe defects 6 formed from the screw dislocation (Super Screw Dislocation) which has a big Burgers vector are decomposed, and it is 1c (in 6 H-SiC, at c= 1.5 nm.). c corresponds to c axial length of a unit cell. While becoming an aggregate (a stacking fault and edge dislocation are included) of several screw dislocations which have the following Burgers vectors, it is presumed that SiC deposited in the hollow hole.

[0045]Because, the direction which is a hollow hole which has the surface in the part and where SiC deposited more, The surface energy disadvantage by forming the surface is solved, and further, In order that the fall of the free energy by molecule of the Secretary of State for the Environment (gaseous phase) being incorporated during a crystal may exceed the loss by the strain energy under crystal produced by the deposit of SiC, there is a profit of free energy as the whole system. For this reason, it is presumed that the sublimation-re-deposit (/rearrangement) advanced (drawing 4 (c), (d)).

[0046]Although it explained that movement (diffusion) of the atom for a blockade was performed via the gaseous phase, the mechanism performed by the diffusion in a solid through a hole and an interstitial atom and the surface diffusion of a micropipe-defects wall surface may also be considered.

[0047]The duty into which heat-treating by covering with the covering material 5 at least one [which has the micropipe defects 6 of this embodiment] field of the silicon carbide monocrystal 1 (the case installed in the lid 3 made from black lead is also included) decomposes the Burgers vector of the micropipe defects 6 (screw dislocation) is achieved, It is presumed that the effect which the micropipe defects 6 are blocked as a result, and serves as the blockade hole 7 was done so.

[0048]On the other hand, when the thing of 4H polymorphism was used as the substrate crystal 1, there were some some which were blocked among two or more micropipe defects 6, and there were some some which are not blocked.

[0049]That is, although it is thought that the covering material 5 has achieved the catalytic operation for the purpose of reducing the activation energy of a blockade of the micropipe defects 6 in a micropipe-defects clogging phenomenon in the case of 6H polymorphism, It seems that the catalysis with the clear covering material 5 is not achieved in the case of 4H polymorphism.

[0050]And unlike the case of 6H polymorphism, in the case of 4H polymorphism, even if a blockade once starts, a blockade does not advance easily. Since this has a difference in those composition rearrangements (a screw dislocation, edge dislocation) and internal strain energy in the micropipe defects 6 under crystal of under the crystal of 4H polymorphism, and 6H polymorphism, At least in one side between polymorphisms and between each micropipe defects 6, it has suggested that the activation energy of a micropipe-defects blockade differs also in the one micropipe defects 6. When it experiments about the thing of 4H polymorphism, the micropipe defects 6 blockade in the shape of a dashed line, and are considered that the activation energy of a micropipe-defects blockade differs also from this.

[0051]Then, since the micropipe defects 6 are blocked thoroughly, the following processes are further performed after a blockade process.

[0052]First, after picking out the substrate crystal 1 from the above-mentioned thermal treatment equipment and removing the covering material 5 from the substrate crystal 1, silicon carbide monocrystal is grown up into the substrate crystal 1 by the sublimating method etc. by using the substrate crystal 1 as a seed crystal.

[0053]At this time, the micropipe defects 6 blocked with the substrate crystal 1 are not inherited by the silicon carbide monocrystal (growth phase) into which the substrate crystal 1 was grown up as a seed crystal, but only the micropipe defects 6 which were not blocked are inherited.

[0054]For this reason, when the thing of 6H polymorphism is used as the substrate crystal 1, the micropipe defects 6 are not inherited by the growth phase, but when the thing of 4H polymorphism is used, the micropipe defects 6 are inherited by the growth phase only about the portion by which the micropipe defects 6 were not blocked.

[0055]Then, the silicon carbide monocrystal grown up is cut down and the above-mentioned blockade process is again repeated by using this cut-down silicon carbide monocrystal as the substrate crystal 1. That is, at least one surface of the cut-down substrate crystal 1 is covered with the covering material 5, and heat treatment of the above-mentioned conditions is performed after that.

[0056]Thereby, when the thing of 4H polymorphism is used as the substrate crystal 1, the micropipe defects 6 which were not blocked at the time of heat treatment of the 1st time are blocked. Thus, by using the phenomenon in which the once blocked micropipe defects 6 are not inherited by the growth phase, Even if the micropipe defects 6 are not thoroughly blocked by the micropipe-defects blockade process of 1 time, all the micropipe defects 6 can be blocked more by giving a micropipe-defects blockade process by using a growth phase as the substrate crystal 1 again.

[0057]And since the micropipe defects 6 under 4H crystal which was difficult until now can be blocked, the silicon carbide monocrystal in which the micropipe defects 6 do not exist substantially can be manufactured regardless of a polymorphism.

[0058]Although the case where the micropipe-defects blockade process of 2 times is performed is shown here, By carrying out by repeating a micropipe-defects blockade process 3 times or more, when the micropipe defects 6 do not blockade thoroughly as a line twice, also when the thing of 4H polymorphism is used as the substrate crystal 1, the micropipe defects 6 can be blockaded thoroughly. As mentioned above, in the case of 4H polymorphism, since the micropipe defects 6 are hard to be blockaded, especially the thing to perform by repeating the above-mentioned blockade process is effective but, and. Since the case where the micropipe defects 6 are not thoroughly blockaded at the micropipe-defects blockade process of 1 time in the case of 6H polymorphism or other polymorphisms is possible, in such a case, it is effective to carry out by repeating the above-mentioned blockade process.

[0059]Thus, by starting the field (0001) (a substrate parallel to a field, or an off-axis board) where the micropipe defects 6 do not exist from the obtained substrate crystal 1, the substrate crystal 1 without the micropipe defects 6 can be obtained. In this way, the obtained substrate crystal can be offered as it is as highly efficient high withstand pressure, high frequency, a high speed, and a substrate for environmental-proof devices. By what is cut down and done for the processing treatment of many substrates from the silicon carbide single crystal ingot which is possible also for offering again the substrate crystal 1 in which the micropipe defects 6 were blockaded as a seed crystal of the sublimating method, and was obtained by this. Sharp reduction of the manufacturing cost of a silicon carbide single crystal substrate can be aimed at.

[0060]And since the micropipe defects 6 once produced with growth can be blockaded in the monocrystal substrate into which the inside of the substrate and its substrate were grown up as a seed crystal, It becomes unnecessary for many growth experiments for expanding one by one, the large caliber-ized process, i.e., the substrate caliber, of a substrate, to take a great labor, and a manufacturing cost can be reduced substantially.

[0061]As a modification of this embodiment, it may be made to perform the above-mentioned heat treatment in the state where the surface-protection member has been further arranged on the covering material 5. When a surface-protection member is arranged on the covering material 5, in thus, the case of heat treatment. The covering material 5 sublimates by heat etching, and does not disappear, and since the state where the opening of the micropipe defects 6 was closed by the covering material 5 without the crevice is realizable at the time of heat treatment, the micropipe defects 6 can be made to certainly blockade. When removing the covering material 5 after forming the blockade hole 7, since the thickness of the covering material 5 or silicon carbide monocrystal does not change compared with heat treatment before, the amount of removal is known correctly, and it can prevent removing to the blockade hole 7.

[0062]As a material of a surface-protection member, high-melting point substances, such as carbon materials, such as refractory metals, such as tungsten and tantalum, and black lead, a silicon carbide substrate, or silicon carbide powder, can be used. Since such materials are comparatively stable also at heat treatment temperature, they are preferred as a surface-protection member.

[0063]Carbonization prevention material may be arranged near the substrate crystal 1 so that the substrate crystal 1 may not carbonize in heat treatment. The simple sectional view of the thermal treatment equipment which has arranged carbonization prevention material is shown in drawing 5. As a carbonization prevention material, gaseous phase raw materials, such as solid materials, such as powder containing SiC and Si, Silang, and propane, etc. can be used, for example. These are effective in preventing heat etching of the covering material 5.

[0064](A 2nd embodiment) Although silicon carbide monocrystal is grown up on the substrate crystal 1 which blockaded the micropipe defects 6, what cut down this silicon carbide monocrystal grown up is again used for the substrate crystal 1 and he is trying to repeat a micropipe-defects blockade process in a 1st embodiment of the above, It may carry out like this embodiment.

[0065]First, a micropipe-defects blockade process is performed to the substrate crystal 1 covered with the covering material 5 like a 1st embodiment, and the micropipe defects 6 of the substrate crystal 1 are blockaded. Thereby, the substrate crystal 1 which no micropipe defects 6 blockade yet is obtained.

[0066]Next, the field where the micropipe defects 6 were blockaded among the substrate crystals 1 is started, and the covering material 5 is again arranged on this started surface. By doing in this way, the position covered with the covering material 5 can be changed.

[0067]Namely, since the activation energy of a blockade differs for every place of the also in the one micropipe defects 6 as it explained in a 1st embodiment, By changing the covering position of the micropipe defects 6, it becomes possible to reduce the activation energy of a blockade, and all the micropipe defects 6 can be blockaded more.

[0068]And a micropipe-defects blockade process is performed in the above-mentioned heat treatment condition. Thereby, if all the micropipe defects 6 have not blockaded thoroughly yet, the surface of the substrate crystal 1 is started and a micropipe-defects blockade process is repeated.

[0069]By doing in this way, the micropipe defects 6 can be thoroughly blockaded within the thickness of the substrate crystal 1. Thus, the substrate crystal 1 in which the micropipe defects 6 were blockaded as well as a 1st embodiment can be used for a highly efficient device, or it can use as a seed crystal for silicon-carbide-monocrystal growth.

[0070]Also in this embodiment, if carbonization prevention material is arranged for the surface of the covering material 5 a wrap and near the substrate crystal 1 by a surface-protection member as the modification of a 1st embodiment showed, the same effect as the above can be acquired.

[0071]As a thermal treatment equipment for a micropipe-defects blockade, as shown in drawing 1, explained the case where arranged the substrate crystal 1 in the upper part of the crucible 2 in which the lid 3 is located, and the

silicon carbide 4 was arranged in the lower part, but. It is good as for a method of a wrap in the substrate crystal 1 with the carbonization prevention material 4 so that it may be shown in devices other than this, for example, drawing 5. It is applicable also to the case where arrange the silicon carbide 4 in the upper part of the crucible 2, and the substrate crystal 1 is arranged in the lower part. Although the thermal treatment equipment of the vertical mold was described, it is applicable also to the thermal treatment equipment of a horizontal type. The same effect is acquired even if a heating method also uses a well-known high-frequency-induction-heating method conventionally. [0072]Although the case where the substrate crystal 1 was silicon carbide was described, a described method is applicable also to the material which has hollow penetration defects, such as the other crystal, for example, ZnS etc.

[0073]

[Example]Hereafter, the example in this embodiment is described concretely.

[0074](Example 1) This example experiments in a 1st embodiment of the above concretely.

[0075]Defect density first prepares the substrate crystal 1 which comprised a SiC single crystal of 4H polymorphism with a thickness of 300 micrometers which has the micropipe defects 6 of about 50-cm^{-2} . As the covering material 5, the CVD method was used for C side of this substrate crystal 1, and the epitaxial film of 3C-SiC was formed in it by a thickness of about 15 micrometers.

[0076]When observed using the differential interference microscope, the polarization microscope, and the scanning electron microscope, the opening of the micropipe defects 6 was closed by the epitaxial film of 3C-SiC without the crevice. The surface of the substrate crystal 1 uses the field just (0001), and, as for the epitaxial film of 3C-SiC, the field (111) is formed as a grown surface.

[0077]Next, where graphite slab about 800 micrometers thick is fixed to the surface of the above-mentioned covering material 5 with carbon system adhesives as a surface-protection member, the substrate crystal 1 has been arranged to the thermal treatment equipment shown in drawing 1. As a micropipe-defects blockade heat treatment process, ambient pressure power performed heat treatment of 24 hours, as the temperature gradient between 2390 **, the silicon carbide 4, and the substrate crystal 1 became 10 ** (temperature of the silicon carbide 4 = 2400 **) in the temperature of $6.67 \times 10^4 \text{Pa}$ (500Torr) and the substrate crystal 1.

[0078]After carrying out mirror polishing of the substrate crystal pass such a process in parallel with a field (0001), the surface was observed in detail using the differential interference microscope and the polarization microscope.

As a result, it is about 20% of the whole which the opening had exposed from the crystal surface among the micropipe defects 6, and about 80% of the remainder had been in the state which does not have an opening in a mirror polishing face, i.e., the state where it was closed thoroughly.

[0079]The sublimating method growth was performed by using as a seed crystal the substrate crystal 1 obtained at such a process. Then, after cutting down and carrying out mirror polishing of the substrate crystal 2 from the monocrystal ingot of 4H obtained polymorphism, micropipe-defects density was evaluated using the polarization microscope. As a result, that micropipe-defects density was about 50-cm^{-2} before giving a micropipe-defects blockade process was decreasing to about 10-cm^{-2} .

[0080]And as a result of repeating the above-mentioned whole process again, micropipe-defects density decreased to about 1-cm^{-2} eventually.

[0081](Example 2) This example experiments in a 2nd embodiment of the above concretely.

[0082]Defect density first prepares the substrate crystal 1 which comprised a SiC single crystal of 4H polymorphism with a thickness of 300 micrometers which has the micropipe defects 6 of about 50-cm^{-2} . As the covering material 5, the CVD method was used for C side of this substrate crystal 1, and the epitaxial film of 3C-SiC was formed in it by a thickness of about 15 micrometers.

[0083]When observed using the differential interference microscope, the polarization microscope, and the scanning electron microscope, the opening of the micropipe defects 6 was closed by the epitaxial film of 3C-SiC without the crevice. The surface of the substrate crystal 1 uses the field just (0001), and, as for the epitaxial film of 3C-SiC, the field (111) is formed as a grown surface.

[0084]Next, where graphite slab about 800 micrometers thick is fixed to the surface of the above-mentioned covering material 5 with carbon system adhesives as a surface-protection member, the substrate crystal 1 has been arranged to the thermal treatment equipment shown in drawing 1. As a micropipe-defects blockade heat treatment process, ambient pressure power performed heat treatment of 24 hours, as the temperature gradient between 2230 **, the silicon carbide 4, and the substrate crystal 1 became 60 ** (temperature of the silicon carbide 4 = 2290 **) in the temperature of $6.67 \times 10^4 \text{Pa}$ and the substrate crystal 1.

[0085]After carrying out mirror polishing of the substrate crystal pass such a process in parallel with a field (0001), the surface was observed in detail using the differential interference microscope and the polarization microscope.

As a result, it is about 45% of the whole which the opening had exposed to the crystal surface among the micropipe defects 6, and about 55% of the remainder had been in the state which does not have an opening in a mirror polishing face, i.e., the state where it was closed thoroughly.

[0086]The above-mentioned process was again repeated using the substrate crystal 1 obtained at such a process. Then, after carrying out mirror polishing of the obtained substrate crystal 1 in parallel with a field (0001), the surface was observed in detail using the differential interference microscope and the polarization microscope. As a result, it is about 25% of the whole which the opening had exposed from the crystal surface among the micropipe defects 6, and the thing of about 75% of the remainder had been in the state which does not have an opening in a mirror

polishing face, i.e., the state where it was closed thoroughly.

[0087]By repeating the above process twice [further], final micropipe-defects density decreased to about 5-cm^{-2} .
 [0088](Example 3) This example shows the case where the thermal treatment equipment shown in drawing 5 is used to Example 1.

[0089]Defect density first prepares the substrate crystal 1 which comprised a SiC single crystal of 4H polymorphism with a thickness of 300 micrometers which has the micropipe defects 6 of about 50-cm^{-2} . As the covering material 5, the CVD method was used for C side of this substrate crystal 1, and the epitaxial film of 3C-SiC was formed in both sides by a thickness of about 15 micrometers in it.

[0090]When observed using the differential interference microscope, the polarization microscope, and the scanning electron microscope, the opening of the micropipe defects 6 was closed by the epitaxial film of 3C-SiC without the crevice. The surface of the substrate crystal 1 uses the field just (0001), and, as for the epitaxial film of 3C-SiC, the field (111) is formed as a grown surface.

[0091]Next, the substrate crystal 1 has been arranged to the thermal treatment equipment shown in drawing 5.

Ambient pressure power as a micropipe-defects blockade heat treatment process $6.67 \times 10^4 \text{ Pa}$ (500Torr). The temperature of the substrate crystal 1 performed heat treatment of 24 hours, as the temperature gradient between the powder mixture and the substrate crystal 1 of SiC and Si as 2390 ** and the carbonization prevention material 4 became several ** (temperature of the carbonization prevention material 4 = 2400 **).

[0092]After carrying out mirror polishing of the substrate crystal pass such a process in parallel with a field (0001), the surface was observed in detail using the differential interference microscope and the polarization microscope. As a result, it is about 10% of the whole which the opening had exposed from the crystal surface among the micropipe defects 6, and about 90% of the remainder had been in the state which does not have an opening in a mirror polishing face, i.e., the state where it was closed thoroughly.

[0093]The sublimating method growth was performed by using as a seed crystal the substrate crystal 1 obtained at such a process. Then, after cutting down and carrying out mirror polishing of the substrate crystal 2 from the monocrystal ingot of 4H obtained polymorphism, micropipe-defects density was evaluated using the polarization microscope. As a result, that micropipe-defects density was about 50-cm^{-2} before giving a micropipe-defects blockade process was decreasing to about 5-cm^{-2} .

[0094]And as a result of repeating the above-mentioned whole process again, micropipe-defects density decreased to about 0.5-cm^{-2} eventually.

[0095](Example 4) This example shows the case where the surface-protection member of the covering material 5 is not used to Example 1.

[0096]Defect density first prepares the substrate crystal 1 which comprised a SiC single crystal of 4H polymorphism with a thickness of 300 micrometers which has the micropipe defects 6 of about 50-cm^{-2} . As the covering material 5, the CVD method was used for C side of this substrate crystal 1, and the epitaxial film of 3C-SiC was formed in it by a thickness of about 15 micrometers.

[0097]When observed using the differential interference microscope, the polarization microscope, and the scanning electron microscope, the opening of the micropipe defects 6 was closed by the epitaxial film of 3C-SiC without the crevice. The surface of the substrate crystal 1 uses the field just (0001), and, as for the epitaxial film of 3C-SiC, the field (111) is formed as a grown surface.

[0098]Next, the substrate crystal 1 has been arranged to the thermal treatment equipment shown in drawing 1, without using the surface-protection member of the covering material 5 used in the 1st example of the above. As a micropipe-defects blockade heat treatment process, ambient pressure power performed heat treatment of 24 hours, as the temperature gradient between 2390 **, the silicon carbide 4, and the substrate crystal 1 became 10 ** (temperature of the silicon carbide 4 = 2400 **) in the temperature of $6.67 \times 10^4 \text{ Pa}$ and the substrate crystal 1.

[0099]After carrying out mirror polishing of the substrate crystal 1 pass such a process in parallel with a field (0001), the surface was observed in detail using the differential interference microscope and the polarization microscope. As a result, what the opening had exposed from the crystal surface among the micropipe defects 6 had been in the state, i.e., the state where it was closed thoroughly, where it is about 85% of the whole, and about 15% of the remainder does not have an opening in a mirror polishing face.

[0100]The sublimating method growth was performed by using as a seed crystal the substrate crystal 1 obtained at such a process. Then, after cutting down and carrying out mirror polishing of the substrate crystal 2 from the monocrystal ingot of 4H obtained polymorphism, micropipe-defects density was evaluated using the polarization microscope. As a result, it only decreased to about 45-cm^{-2} that micropipe-defects density was about 50-cm^{-2} before giving a micropipe-defects blockade process.

[0101]And as a result of repeating the above-mentioned whole process again, micropipe-defects density decreased slightly to about 40-cm^{-2} eventually.

[0102]Thus, also when there is no surface-protection member, the micropipe defects 6 are blockaded, but since heat etching of the covering material 5 is carried out, it can be said that the blockade of the micropipe defects 6 is not enough compared with the case where there is a surface-protection member.

[0103](Example 5) This example is a case where it heat-treats at low temperature comparatively rather than the temperature conditions of heat treatment in the above-mentioned embodiment.

[0104]Defect density first prepares the substrate crystal 1 which comprised a SiC single crystal of 4H polymorphism

with a thickness of 300 micrometers which has the micropipe defects 6 of about 50-cm^{-2} . As the covering material 5, the CVD method was used for C side of this substrate crystal 1, and the epitaxial film of 3C-SiC was formed in it by a thickness of about 15 micrometers.

[0105]When observed using the differential interference microscope, the polarization microscope, and the scanning electron microscope, the opening of the micropipe defects 6 was closed by the 3C-SiC epitaxial film without the crevice. The surface of the substrate crystal 1 uses the field just (0001), and, as for the 3C-SiC epitaxial film, the field (111) is formed as a grown surface.

[0106]Next, where a GURAFITO board about 800 micrometers thick is fixed to the surface of the above-mentioned covering material 5 with carbon system adhesives, the substrate crystal 1 has been arranged to the thermal treatment equipment shown in drawing 1. As a micropipe-defects blockade heat treatment process, ambient pressure power performed heat treatment of 24 hours, as the temperature gradient between 2100 **, the silicon carbide 4, and the substrate crystal 1 became 10 ** in the temperature of $6.65 \times 10^4 \text{Pa}$ and the substrate crystal 1.

[0107]After carrying out mirror polishing of the substrate crystal pass such a process in parallel with a field (0001), the surface was observed in detail using the differential interference microscope and the polarization microscope. As a result, it is about 80% of the whole which the opening had exposed from the crystal surface among the micropipe defects 6, and about 20% of the remainder had been in the state which does not have an opening in a mirror polishing face, i.e., the state where it was closed thoroughly.

[0108]The sublimating method growth was performed by using as a seed crystal the substrate crystal 1 obtained at such a process. Then, after cutting down and carrying out mirror polishing of the substrate crystal 2 from the monocrystal ingot of 4H obtained polymorphism, micropipe-defects density was evaluated using the polarization microscope. As a result, that micropipe-defects density was about 50-cm^{-2} before giving a micropipe-defects blockade process was decreasing to about 40-cm^{-2} .

[0109]And as a result of repeating the above-mentioned whole process again, micropipe-defects density decreased to about 30-cm^{-2} eventually.

[0110]Thus, from the above-mentioned temperature conditions, even if it is low temperature comparatively, the effect which blockades the micropipe defects 6 is acquired, but it can be said that it is preferred to consider it as the temperature conditions shown by a 1st embodiment.

[Translation done.]

* NOTICES *

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.*** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DESCRIPTION OF DRAWINGS

[Brief Description of the Drawings]

[Drawing 1]It is a figure when the substrate crystal 1 has been arranged in the thermal treatment equipment which applies a 1st embodiment of this invention.

[Drawing 2]It is the figure to which the neighborhood of the substrate crystal 1 shown in drawing 1 was expanded.

[Drawing 3]It is a figure showing the appearance of the substrate crystal 1 after performing heat treatment as a micropipe-defects blockade process.

[Drawing 4]It is a figure for explaining the mechanism of a micropipe-defects blockade.

[Drawing 5]It is a figure for explaining the thermal treatment equipment which has arranged carbonization prevention material.

[Description of Notations]

1 [— A silicon carbide raw material, 5 / — Covering material, 6 / — Micropipe defects, 7 / — Blockade hole.] —
A substrate crystal, 2 — A crucible, 3 — A lid, 4

[Translation done.]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号
特開2001-158697
(P2001-158697A)

(43) 公開日 平成13年6月12日 (2001.6.12)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テームコード [*] (参考)
C 3 0 B	29/36	C 3 0 B	29/36
H 0 1 L	21/205	H 0 1 L	21/205
	21/324		21/324
			X

審査請求 未請求 請求項の数 8 O L (全 10 頁)

(21) 出願番号 特願平11-338391

(22) 出願日 平成11年11月29日 (1999. 11. 29)

(71) 出願人 000003609

株式会社豊田中央研究所

愛知県愛知郡長久手町大字長湫字横道41番地の1

(71) 出願人 000004260

株式会社デンソー

愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地

(72) 発明者 岡本 篤人

愛知県愛知郡長久手町大字長湫字横道41番地の1 株式会社豊田中央研究所内

(74) 代理人 100100022

弁理士 伊藤 洋二 (外2名)

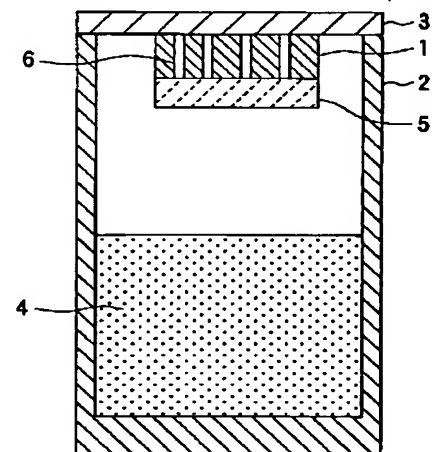
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 炭化珪素単結晶及びその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 炭化珪素単結晶に存在しているマイクロバンプ欠陥を炭化珪素単結晶の内部で閉塞させる。

【解決手段】 基板結晶1を用意し、マイクロバンプ欠陥6の開口部を被覆材料5で被覆する。そして、熱処理を施すと、基板結晶1に存在するマイクロバンプ欠陥6を基板結晶1の内部で閉塞させることができる。この後、被覆材料5を除去した後、基板結晶1を種結晶として炭化珪素単結晶を成長させ、この成長させた炭化珪素単結晶を再度基板結晶1として、基板結晶1を被覆材料5で覆い、熱処理による閉塞工程を繰り返す。マイクロバンプ欠陥が閉塞した基板結晶を種結晶として炭化珪素単結晶を成長させた場合、閉塞された部分ではマイクロバンプ欠陥が継承されないため、成長させた炭化珪素単結晶を再度基板結晶1として閉塞工程を行えば、よりマイクロバンプ欠陥を閉塞することができる。



- 1: 炭化珪素単結晶 (基板結晶)
- 2: るつぽ
- 3: 炉体
- 4: 炭化珪素
- 5: 被覆材料
- 6: マイクロバンプ欠陥
- 7: 閉塞孔

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 マイクロバンプ欠陥（6）を有する炭化珪素単結晶からなる基板結晶（1）を用意する工程と、前記基板結晶に形成された前記マイクロバンプ欠陥の開口部の少なくとも一方を被覆材料（5）で被覆する被覆工程と、

熱処理を施すことにより、前記基板結晶に存在する前記マイクロバンプ欠陥を前記基板結晶の内部で閉塞させ、前記マイクロバンプ欠陥の少なくとも一部を閉塞孔

（7）にする閉塞工程と、

前記マイクロバンプ欠陥の一部が閉塞孔となった前記基板結晶の前記被覆材料を除去したのち、該基板結晶を種結晶として炭化珪素単結晶を成長させる成長工程とを含み、

前記成長させた炭化珪素単結晶を再度基板結晶として、前記被覆工程、前記閉塞工程及び成長工程を少なくとも一回繰り返し、該基板結晶に形成されているマイクロバンプ欠陥を閉塞させることを特徴とする炭化珪素単結晶の製造方法。

【請求項 2】 マイクロバンプ欠陥（6）を有する炭化珪素単結晶からなる基板結晶（1）を用意する工程と、前記基板結晶に形成されたマイクロバンプ欠陥の開口部の少なくとも一方を被覆材料（5）で被覆する被覆工程と、

熱処理を施すことにより、前記基板結晶に存在する前記マイクロバンプ欠陥を前記基板結晶の内部で閉塞させ、前記マイクロバンプ欠陥の少なくとも一部を閉塞孔

（7）にする閉塞工程とを有し、

前記マイクロバンプ欠陥が閉塞孔となった前記基板結晶の前記被覆材料を除去したのち、再度、前記被覆工程及び前記閉塞工程を行う工程を少なくとも一回繰り返し、前記基板結晶に形成されているマイクロバンプ欠陥を閉塞させることを特徴とする炭化珪素単結晶の製造方法。

【請求項 3】 前記閉塞工程では、前記熱処理温度を 2200～2500℃とすることを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の炭化珪素単結晶の製造方法。

【請求項 4】 前記被覆工程では、前記基板結晶のうちの（000-1）C面を前記被覆材料で被覆することを特徴とする請求項 1 乃至 3 のいずれか 1 つに記載の炭化珪素単結晶の製造方法。

【請求項 5】 前記被覆工程では、前記被覆材料の表面に、該被覆材料が熱エッチングされることを防止するための表面保護膜を配置する工程を含むことを特徴とする請求項 1 乃至 4 のいずれか 1 つに記載の炭化珪素単結晶の製造方法。

【請求項 6】 前記閉塞工程では、前記被覆材料で被覆された前記基板結晶を炭化防止材料で覆った状態で前記熱処理を行うことを特徴とする請求項 1 乃至 5 のいずれか 1 つに記載の炭化珪素単結晶の製造方法。

【請求項 7】 前記基板結晶として 4 H 多形の炭化珪素

単結晶を用いることを特徴とする請求項 1 乃至 6 のいずれか 1 つに記載の炭化珪素単結晶の製造方法。

【請求項 8】 請求項 1 乃至 7 のいずれか一つに記載の炭化珪素単結晶製造方法を用いて製造された、マイクロバンプ欠陥が閉塞された閉塞孔を有する基板結晶を種結晶として、該種結晶上に炭化珪素単結晶を成長させることを特徴とする炭化珪素単結晶の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

10 【発明の属する技術分野】本発明は、マイクロバンプ欠陥が閉塞された炭化珪素（SiC）単結晶の製造方法およびマイクロバンプ欠陥が閉塞された炭化珪素単結晶に関する。

【0002】

【従来の技術】SiC単結晶を種結晶として、改良レーリー法（昇華法）にてSiC単結晶を製造する際、マイクロバンプ欠陥（中空貫通欠陥）と呼ばれる直径サブμm乃至数μmの中空貫通孔が略成長方向に沿って伸長し、成長結晶中に内在される。マイクロバンプ欠陥はデバイスの電気的特性に悪影響を与えるため、マイクロバンプ欠陥があるSiC単結晶はデバイス形成用の基板に適さない。このため、マイクロバンプ欠陥を低減することが重要な課題となっている。

【0003】マイクロバンプ欠陥の低減方法として、米国特許第5,679,153号明細書や特許第2804860号公報や特許第2876122号公報に示される方法が提案されている。

【0004】米国特許第5,679,153号明細書に示される方法は、シリコン中のSiC溶融を用いた液相エピタキシー法によって結晶成長させると、エピタキシャル成長途中でマイクロバンプ欠陥が閉塞されていくことを利用して、マイクロバンプ欠陥を有する種結晶（欠陥密度：50～400cm⁻²）上にマイクロバンプ欠陥が低減されたエピタキシャル層（欠陥密度：0～50cm⁻²）を成長させている。

【0005】特許第2804860号公報に示される方法は、種結晶の成長面として（0001）面に垂直な面を使用することによって、アルカリエッチングに際し、六角形エッチビットが全く観察されない単結晶、つまりマイクロバンプ欠陥が存在しない単結晶を種結晶上に成長させている。

【0006】特許第2876122号公報に示されている方法は、α（六方晶）-SiC単結晶基板（種結晶）の表面に、熱化学的蒸着（CVD）法によりβ（立方晶）-SiCもしくはα-SiCの多結晶膜の成膜と、それによって得られた複合体に対する熱処理とを複数回繰り返すことにより、複数層のβ-SiCもしくはα-SiC多結晶膜をα-SiC単結晶基板（種結晶）の結晶軸と同一方位に配向（ある種の固相エピタキシャル成長）させることによって、種結晶上にマイクロバンプ欠

陥などの結晶欠陥のない高品質、かつ、高膜厚の単結晶 SiC を成長させている。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】上記した3つの方法は共に、種結晶上に新たな単結晶を成長させ、その成長層においてマイクロパイプ欠陥密度を低減するようにしている。

【0008】このため、第1の方法では、マイクロパイプ欠陥が無い部分を得るために、液相エピタキシー法にて20～75 μ m以上のエピタキシャル層を成長させなければならず、また、その範囲以下では、依然としてマイクロパイプ欠陥が存在するという問題がある。また、このように形成されたエピタキシャル層を種結晶として、再び昇華法によって単結晶成長を行うと、マイクロパイプ欠陥が閉塞された部分が薄いことから、その閉塞された部分が昇華して再びマイクロパイプ欠陥の開口部を生じる可能性があり、種結晶の試料調整や昇華法成長条件の適正化が困難であるという問題もある。

【0009】一方、第2の方法では、マイクロパイプ欠陥の発生を抑制する点では効果があるが、成長させた単結晶に新たな積層欠陥が導入されるため、基板の電気的特性に異方性を生じ、電子デバイス用基板としては適さないという問題がある。

【0010】他方、第3の方法では、 α -SiC単結晶基板(種結晶)の表面にCVD法で β -SiCもしくは α -SiC多結晶膜を形成するため、結晶粒界を内在したSiC複合体が得られる。この複合体を熱処理し、種結晶上に固相エピタキシャル成長させると、 β -SiCもしくは α -SiC多結晶膜中の結晶子が派生成長(over growth)して明確な結晶粒界は熱処理とともに減少していくが、上記結晶粒界や不均一相変態に伴う結晶境界などにおける内部歪みを原因とした結晶欠陥が導入される危険がある。こうした欠陥はキャリアのトラップ源となるため電子デバイス用基板としては適さないという問題がある。

【0011】本発明は上記問題に鑑みてなされ、新たな成長層においてマイクロパイプ欠陥の発生、継承を抑制するのではなく、炭化珪素単結晶に存在しているマイクロパイプ欠陥を炭化珪素単結晶の内部で閉塞させることができるようにすることを目的とする。

【0012】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため、請求項1に記載の発明では、マイクロパイプ欠陥(6)を有する炭化珪素単結晶からなる基板結晶(1)を用意する工程と、基板結晶に形成されたマイクロパイプ欠陥の開口部の少なくとも一方を被覆材料(5)で被覆する被覆工程と、熱処理を施すことにより、基板結晶に存在するマイクロパイプ欠陥を基板結晶の内部で閉塞させ、マイクロパイプ欠陥の少なくとも一部を閉塞孔(7)にする閉塞工程と、マイクロパイプ欠陥の一部が

閉塞孔となった基板結晶の被覆材料を除去したのち、該基板結晶を種結晶として炭化珪素単結晶を成長させる成長工程とを含み、成長させた炭化珪素単結晶を再度基板結晶として、被覆工程、閉塞工程及び成長工程を少なくとも一回繰り返し、基板結晶に形成されているマイクロパイプ欠陥を閉塞させることを特徴としている。

【0013】このように、炭化珪素単結晶からなる基板結晶を被覆材料で覆って熱処理を行えば、基板結晶の内部でマイクロパイプ欠陥を閉塞させることができる。そして、マイクロパイプ欠陥が閉塞した基板結晶を種結晶として炭化珪素単結晶を成長させた場合には、閉塞された部分については炭化珪素単結晶にマイクロパイプ欠陥が継承されないため、成長させた炭化珪素単結晶を再度基板結晶に用いて、被覆工程、閉塞工程、成長工程を少なくとも一回繰り返せば、さらにマイクロパイプ欠陥を閉塞することができる。特に、請求項7に示すように、4H多形の炭化珪素単結晶はマイクロパイプ欠陥が閉塞されにくいいため、繰り返し閉塞工程を行うことが有効となる。

【0014】請求項2に記載の発明においては、マイクロパイプ欠陥(6)を有する炭化珪素単結晶からなる基板結晶(1)を用意する工程と、基板結晶に形成されたマイクロパイプ欠陥の開口部の少なくとも一方を被覆材料(5)で被覆する被覆工程と、熱処理を施すことにより、基板結晶に存在するマイクロパイプ欠陥を基板結晶の内部で閉塞させ、マイクロパイプ欠陥の少なくとも一部を閉塞孔(7)にする閉塞工程とを有し、マイクロパイプ欠陥が閉塞孔となった基板結晶の被覆材料を除去したのち、再度、被覆工程及び閉塞工程を行う工程を少なくとも一回繰り返し、基板結晶に形成されているマイクロパイプ欠陥を閉塞させることを特徴としている。

【0015】このように、マイクロパイプ欠陥の閉塞工程を行った後、被覆工程、閉塞工程を繰り返し行うことで、1回目の閉塞工程で閉塞しなかったマイクロパイプ欠陥も、2回目の閉塞工程で閉塞のための活性化エネルギーが低い場所に確率的に被覆層が形成されるために、より多くのマイクロパイプ欠陥を閉塞することができる。

【0016】なお、請求項3に示すように、閉塞工程では、熱処理温度を2200～2500℃とするのが望ましい。より好ましくは熱処理温度を2400℃前後にするのがよい。

【0017】請求項4に記載の発明においては、被覆工程では、基板結晶のうちの(000-1)C面を被覆材料で被覆することを特徴としている。

【0018】この(000-1)C面は4H多形の炭化珪素単結晶を成長させ易い面であるため、この面においてマイクロパイプ欠陥を閉塞することにより、閉塞後に4H多形の炭化珪素単結晶を成長させるのに好適である。

【0019】請求項5に記載の発明においては、被覆工程では、被覆材料の表面に表面保護膜を配置する工程を含むことを特徴としている。

【0020】このように、被覆材料の表面に表面保護膜を配置することにより、被覆材料が熱処理中に熱エッチングによって除去されてしまうことを防止でき、マイクロバイブ欠陥を確実に被覆することができる。

【0021】請求項6に記載の発明においては、閉塞工程では、被覆材料で被覆された基板結晶を炭化防止材料で覆った状態で熱処理を行うことを特徴としている。

【0022】このように、基板結晶を炭化防止材料で覆うようにすることで、熱処理中に基板結晶が炭化されることを防止することができる。この炭化防止材料としては、SiCとSiを含む粉末などの固体原料、シラン、プロパンなどの気相原料などが有効である。また、これらは、被覆材料5の熱エッチングを防止する効果もある。

【0023】なお、上記各手段の括弧内の符号は、後述する実施形態に記載の具体的手段との対応関係を示すものである。

【0024】

【発明の実施の形態】（第1実施形態）以下、図に示す実施形態について説明する。

【0025】図1に、基板結晶（炭化珪素単結晶）1のマイクロバイブ欠陥6を閉塞するのに用いる熱処理装置の概略断面図を示す。

【0026】熱処理装置は、上部が開いたるつぼ2と、るつぼ2の開口部を覆う蓋体3により構成されている。これらるつぼ2と蓋体3はグラファイトで構成されている。

【0027】るつぼ2内には、マイクロバイブ欠陥6を閉塞するための熱処理を再現性良く安定に行うための原料となる炭化珪素4が収容されている。基板結晶1は蓋体3上に支持されるようになっており、るつぼ2の開口部を蓋体3で覆ったときに、基板結晶1が炭化珪素4に対向配置されるようになっている。以下、基板結晶1の両表面のうち載置面側を載置面側表面といい、載置面の反対側を非載置面側表面という。

【0028】なお、図1において図示していないが、るつぼ2の外周には、グラファイト製の抵抗発熱体が配置されており、この抵抗発熱体によってるつぼ2内の温度、具体的には基板結晶1の温度や炭化珪素4の温度が調整可能となっている。また、図示されていないが、るつぼ2は雰囲気圧力を調整できる容器内に入れられており、るつぼ2内への不活性ガス等の導入や、雰囲気圧力の調整が可能となっている。

【0029】図1の基板結晶1の近傍を拡大したものを図2に示す。図2に示すように、基板結晶1の少なくとも一方の表面（本図では非載置面側）を被覆材料5で覆っている。例えば、基板結晶1の(000-1)C面を

被覆材料5で覆うようにしている。このようなC面（カーボン面）は、4H多形を安定に成長させる結晶面であるため、C面においてマイクロバイブ欠陥6を閉塞すれば、閉塞した後に閉塞された基板を種結晶として4H多形の炭化珪素単結晶を成長させるのに好適である。

【0030】この被覆材料5は、後述するマイクロバイブ欠陥閉塞のための熱処理に先立って、例えば、化学蒸着（CVD）法や分子線エビタキシー（MBE）法やスパッタ蒸着法や昇華法などの気相成長法、液相エビタキシー（LPE）法などの液相成長法によって予め基板結晶1上に堆積させたものである。

【0031】被覆材料5には基板結晶1と同じ結晶形のSiC、異種多形のSiCいずれも適用可能であるが、基板結晶1の材料が六方晶形炭化珪素単結晶の場合、立方晶（3C多形）の炭化珪素エビタキシャル膜が適している。

【0032】この他、被覆材料5として、SiC多結晶体、SiC焼結体、アモルファスSiC、カーボン材料（例えば黒鉛、カーボンナノチューブ、フラーレン等）、珪素を含む材料とカーボン材料の複合体、及び高融点物質（例えば、タングステン、炭化タングステン、窒化ホウ素等）を適用することもできる。

【0033】なお、図1、図2では、基板結晶1の非載置面側表面を被覆材料5で覆っているが、基板結晶1の両表面の少なくとも一方を被覆材料5で覆っていればよく、必ずしも非載置面側表面である必要はないが非載置面側表面であることが望ましい。また、後述する熱処理に先立って被覆材料5を基板結晶1上に形成させてもよいが、熱処理工程中に基板結晶1の表面に形成させてもよい。

【0034】この被覆材料5は、数 μm ～数 mm の範囲で選択することができるが、マイクロバイブ欠陥閉塞のための熱処理条件の自由度と製造コストを考慮すると、数 $10\mu\text{m}$ ～数 $100\mu\text{m}$ の範囲で選択することが好ましい。

【0035】また、基板結晶1の厚さも任意に選択可能であるが、基板結晶1を厚くした方がよりマイクロバイブ欠陥がないものを一度に多く形成できること、さらに基板結晶1が薄すぎると変形、破損の可能性があり製造プロセス中の操作性に難点があるということを考慮すると、少なくとも $100\mu\text{m}$ 以上とするのが望ましい。

【0036】このように構成される基板結晶1を図1に示す熱処理装置内に配置したのち、熱処理を施す。

【0037】このとき、熱処理の温度条件としては、基板結晶1の温度を、 $1800\sim 2500^{\circ}\text{C}$ の範囲となるようにする。特に基板結晶1が4H多形の場合、基板結晶1の温度が $2200\sim 2500^{\circ}\text{C}$ の範囲となるように通常の昇華法よりも比較的高温な熱処理温度としている。このような温度範囲とした理由は、 2200°C よりも低温であるとマイクロバイブ欠陥6が閉塞しにくいと

いう問題があり、2500℃よりも高温であると基板結晶1が炭化するという問題があるためである。このような熱処理温度を選択することにより、基板結晶1の構成原子の気相拡散、固相拡散、表面拡散が促進され、閉塞速度を向上させることが可能になる。なお、後述する実施例で示すように、種々の実験によれば、2400℃前後の温度がマイクロバンプ欠陥閉塞に最も適した熱処理温度であった。

【0038】そして、基板結晶1として、例えば、6H多形、4H多形のものを用いて上記条件の熱処理を施した。このマイクロバンプ欠陥6の閉塞工程を行った後の様子を図3に示す。この図は、基板結晶1として6H多形のものを用いたときのマイクロバンプ欠陥閉塞工程後の断面を示したものである。

【0039】この図に示されるように、基板結晶1として6H多形のものを用いた場合には、基板結晶1の表面に開口を有していたマイクロバンプ欠陥6のすべてが基板結晶1の表面の少なくとも一方向から閉塞された閉塞孔7となっていた。

【0040】マイクロバンプ欠陥6が閉塞されるメカニズムについては、以下のように推測される。

【0041】マイクロバンプ欠陥6は大きなバーガースベクトルを有するらせん転位芯が、大きな弾性歪みエネルギーを緩和するために中空貫通孔になったものと考えられている(F. C. Frank, Acta. Cryst. 4 (1951) 497参照)。

【0042】マイクロバンプ欠陥6の閉塞現象は上記マイクロバンプ欠陥6のメカニズムとは逆の現象が起きていると推定される。マイクロバンプ欠陥6の閉塞推定モデルを図4を用いて説明する。

【0043】被覆材料5として3C-SiCエピタキシャル膜が形成されたマイクロバンプ欠陥6を含む基板結晶1が黒鉛製の蓋体3に設置されている場合を考える

(図4(a))。この状態で図1に示した熱処理装置内に配置し、適当な温度・圧力条件にて熱処理を行うと、その温度における平衡蒸気圧を保つために、マイクロバンプ欠陥6の周辺、3C-SiCエピタキシャル膜及び蓋体のグラファイトから、Si、SiC₂、Si₂C等の蒸気種が図中の矢印のように昇華する。(図4(b))。

【0044】その後、現在まだ理由は明らかでないが、閉塞箇所の透過電子顕微鏡観察結果から、黒鉛製の蓋体3との界面及び被覆材との界面において、大きなバーガースベクトルを有するらせん転位(Super Screw Dislocation)から形成されるマイクロバンプ欠陥6が分解されて、1c(6H-SiCの場合、c=1.5nmで、cは単位格子のc軸長に対応する。)以下のバーガースベクトルを有する数本のらせん転位の集合体(積層欠陥、刃状転位を含む)となるとともに、中空孔にSiCが析出したと推定される。

【0045】なぜなら、その箇所においては、表面を有する中空孔であるよりSiCが析出した方が、表面を形成していることによる表面エネルギー不利が解消され、さらに、環境相(気相)の分子が結晶中に組み込まれることによる自由エネルギーの低下が、SiCの析出によって生じる結晶中の歪みエネルギーによる損失を上回るため、全系として自由エネルギーの利得がある。このため、昇華-再析出(再配列)が進行したと推定される(図4(c)(d))。

10 【0046】なお、閉塞のための原子の移動(拡散)は気相を介して行われるよう説明したが、空孔、格子間原子を介した固体内拡散、マイクロバンプ欠陥内壁表面の表面拡散によって行われるメカニズムも考えられ得る。

【0047】本実施形態のマイクロバンプ欠陥6を有する炭化珪素単結晶1の少なくとも一方の面を被覆材料5で被覆して(黒鉛製蓋体3に設置しただけの場合も含む)熱処理を行うことがマイクロバンプ欠陥6(らせん転位)のバーガースベクトルを分解する役目を果たし、結果的にマイクロバンプ欠陥6が閉塞されて閉塞孔7となる効果を奏したと推定される。

【0048】一方、基板結晶1として4H多形のものを用いた場合には、複数のマイクロバンプ欠陥6のうち閉塞されたものもあれば、閉塞されていないものもあった。

【0049】つまり、6H多形の場合には、被覆材料5はマイクロバンプ欠陥閉塞現象においてマイクロバンプ欠陥6の閉塞の活性化エネルギーを低下させるという意味で触媒的な作用を果たしていると考えられるが、4H多形の場合、被覆材料5が明確な触媒作用を果たしていないようである。

30 【0050】しかも、6H多形の場合とは異なり、4H多形の場合は、一旦閉塞が始まっても容易に閉塞が進行しない。これは、4H多形の結晶中と6H多形の結晶中のマイクロバンプ欠陥6において、それらの構成転位(らせん転位、刃状転位)および内部歪みエネルギーに差があるため、多形間や各マイクロバンプ欠陥6の間の少なくとも一方において、若しくは一本のマイクロバンプ欠陥6においてもマイクロバンプ欠陥閉塞の活性化エネルギーが異なることを示唆している。

40 【0051】このとき、基板結晶1を種結晶として成長させた炭化珪素単結晶(成長層)には、基板結晶1で閉塞するためには閉塞工程の後にさらに以下の工程を行う。

【0052】まず、上記熱処理装置から基板結晶1を取り出し、基板結晶1から被覆材料5を除去したのち、基板結晶1を種結晶として、昇華法などにより基板結晶1に炭化珪素単結晶を成長させる。

50 【0053】このとき、基板結晶1を種結晶として成長させた炭化珪素単結晶(成長層)には、基板結晶1で閉

塞されたマイクロバンプ欠陥6は継承されず、閉塞されてなかったマイクロバンプ欠陥6のみが継承される。

【0054】このため、基板結晶1として6H多形のものを用いた場合には、マイクロバンプ欠陥6が成長層に継承されず、4H多形のものを用いた場合においても、マイクロバンプ欠陥6が閉塞されなかった部分についてだけマイクロバンプ欠陥6が成長層に継承される。

【0055】この後、成長させた炭化珪素単結晶を切り出し、この切り出した炭化珪素単結晶を再度基板結晶1として、上記閉塞工程を繰り返す。すなわち、切り出した基板結晶1の少なくとも一方の表面を被覆材料5で覆い、その後、上記条件の熱処理を行う。

【0056】これにより、基板結晶1として4H多形のものを用いた場合においても、1度目の熱処理時には閉塞されなかったマイクロバンプ欠陥6が閉塞される。このように、一旦閉塞されたマイクロバンプ欠陥6が成長層に継承されない現象を利用することにより、1度のマイクロバンプ欠陥閉塞工程によってマイクロバンプ欠陥6が完全に閉塞されなくても、成長層を再度基板結晶1としてマイクロバンプ欠陥閉塞工程を施すことで、よりすべてのマイクロバンプ欠陥6を閉塞することができる。

【0057】そして、これまで困難だった4H結晶中のマイクロバンプ欠陥6を閉塞することができるため、多形を問わず、マイクロバンプ欠陥6が実質的に存在しない炭化珪素単結晶を製造することができる。

【0058】なお、ここでは、2度のマイクロバンプ欠陥閉塞工程を行う場合を示しているが、2度行ってもマイクロバンプ欠陥6が完全に閉塞しない場合には、3度以上マイクロバンプ欠陥閉塞工程を繰り返し行うことによって、基板結晶1として4H多形のものを用いた場合にもマイクロバンプ欠陥6を完全に閉塞することができる。また、上述したように、4H多形の場合にはマイクロバンプ欠陥6が閉塞されにくいため上記閉塞工程を繰り返し行うことが特に有効であるが、6H多形やその他の多形の場合においても、1度のマイクロバンプ欠陥閉塞工程で完全にマイクロバンプ欠陥6が閉塞されなかった場合が有り得るため、このような場合には上記閉塞工程を繰り返し行うことが有効である。

【0059】このようにして得られた基板結晶1からマイクロバンプ欠陥6が存在しない領域（(0001)面に平行な基板若しくはoff-axis基板）を切り出すことによって、全くマイクロバンプ欠陥6のない基板結晶1を得ることができる。こうして得られた基板結晶は、そのまま高性能の高耐圧、高周波数、高速、耐環境デバイス用の基板として供することができる。また、マイクロバンプ欠陥6が閉塞された基板結晶1を再び昇華法の種結晶として供することも可能であり、これにより得られた炭化珪素単結晶インゴットから数多くの基板を切り出して加工処理することで、炭化珪素単結晶基板の

製造コストの大幅な低減を図ることができる。

【0060】そして、一旦成長によって生じたマイクロバンプ欠陥6を、その基板中やその基板を種結晶として成長させた単結晶基板中で閉塞できるため、基板の大口径化プロセス、すなわち、基板口径を順次拡大するための数多くの成長実験に多大な労力を要する必要がなくなり、製造コストを大幅に削減することができる。

【0061】本実施形態の変形例として、被覆材料5の上にさらに表面保護部材を配置した状態で上記熱処理を行うようにしてもよい。このように、表面保護部材を被覆材料5上に配置すると、熱処理の際、被覆材料5が熱エッチングにより昇華して消失してしまうことがなく、マイクロバンプ欠陥6の開口部が、被覆材料5によって隙間なく塞がれた状態を熱処理時に実現できるため、マイクロバンプ欠陥6を確実に閉塞させることができる。また、閉塞孔7を形成した後、被覆材料5を除去する際に、被覆材料5や炭化珪素単結晶の厚さが熱処理前と比べて変化しないため除去量が正確にわかり、閉塞孔7まで除去してしまうことを防止できる。

【0062】表面保護部材の材料としては、タングステン、タンタルなどの高融点金属、黒鉛などのカーボン材料、炭化珪素基板あるいは炭化珪素粉末などの高融点物質を用いることができる。これらの材料は熱処理温度においても比較的安定であるので表面保護部材として好ましい。

【0063】また、熱処理において基板結晶1が炭化しないように、基板結晶1の近傍に炭化防止材料を配置してもよい。図5に炭化防止材料を配置した熱処理装置の簡略断面図を示す。炭化防止材料として、例えば、SiCとSiを含む粉末などの固体原料、シラン、プロパンなどの気相原料などを用いることができる。また、これらは、被覆材料5の熱エッチングを防止する効果もある。

【0064】（第2実施形態）上記第1実施形態では、マイクロバンプ欠陥6を閉塞した基板結晶1の上に炭化珪素単結晶を成長させ、この成長させた炭化珪素単結晶を切り出したものを再度基板結晶1に用いてマイクロバンプ欠陥閉塞工程を繰り返すようにしているが、本実施形態のようにしてもよい。

【0065】まず、第1実施形態と同様に、被覆材料5によって被覆した基板結晶1に対してマイクロバンプ欠陥閉塞工程を行い、基板結晶1のマイクロバンプ欠陥6を閉塞する。これにより、まだすべてのマイクロバンプ欠陥6が閉塞していない基板結晶1が得られる。

【0066】次に、基板結晶1のうち、マイクロバンプ欠陥6が閉塞された領域を切り出し、この切り出した表面に再度被覆材料5を配置する。このようにすることで、被覆材料5によって被覆する位置を変化させることができる。

【0067】すなわち、第1実施形態において説明した

ように、1本のマイクロパイプ欠陥6においてもその場所毎に閉塞の活性化エネルギーが異なるため、マイクロパイプ欠陥6の被覆位置を変化させることによって、閉塞の活性化エネルギーを低下させることが可能となり、よりすべてのマイクロパイプ欠陥6を閉塞することができる。

【0068】そして、上記熱処理条件にてマイクロパイプ欠陥閉塞工程を行う。これにより、まだすべてのマイクロパイプ欠陥6が完全に閉塞していなければ、また基板結晶1の表面を切り出し、マイクロパイプ欠陥閉塞工程を繰り返す。

【0069】このようにすることで、基板結晶1の厚み内でマイクロパイプ欠陥6を完全に閉塞することができる。このようにマイクロパイプ欠陥6が閉塞された基板結晶1も第1実施形態と同様に高性能デバイスに使用したり、炭化珪素単結晶成長用の種結晶として用いることができる。

【0070】本実施形態においても、第1実施形態の変形例で示したように、被覆材料5の表面を表面保護部材で覆う、及び基板結晶1の近傍に炭化防止材料を配置するようにすれば、上記と同様の効果を得ることができる。

【0071】なお、マイクロパイプ欠陥閉塞のための熱処理装置として、図1に示すように、蓋体3が位置するつば2の上部に基板結晶1を配置し、下部に炭化珪素4を配置する場合について説明したが、これ以外の装置、例えば図5に示すように炭化防止材料4で基板結晶1を覆うようにしてもよい。また、つば2の上部に炭化珪素4、下部に基板結晶1を配置する場合についても適用可能である。また、縦型の熱処理装置について述べたが、横型の熱処理装置にも適用可能である。さらに、加熱方式も従来周知の高周波誘導加熱方式を用いても同様の効果が得られる。

【0072】なお、基板結晶1が炭化珪素の場合について述べたが、それ以外の結晶、例えば、ZnS等の中空貫通欠陥を有する材料にも上記方法を適用することができる。

【0073】

【実施例】以下、本実施形態における実施例について具体的に説明する。

【0074】（実施例1）本実施例は、上記第1実施形態を具体的に実験したものである。

【0075】まず欠陥密度が約 50 cm^{-2} のマイクロパイプ欠陥6を有する厚さ $300\text{ }\mu\text{m}$ の4H多形のSiC単結晶で構成された基板結晶1を用意し、この基板結晶1のC面に被覆材料5として3C-SiCのエピタキシャル膜をCVD法を用いて約 $15\text{ }\mu\text{m}$ の厚さで形成した。

【0076】微分干渉顕微鏡、偏光顕微鏡、走査型電子顕微鏡を用いて観察したところ、マイクロパイプ欠陥6

の開口部は3C-SiCのエピタキシャル膜によって隙間なく塞がれていた。なお、基板結晶1の表面は(0001)ジャスト面を用いており、3C-SiCのエピタキシャル膜は(111)面を成長面として成膜されている。

【0077】次に、上記被覆材料5の表面に表面保護部材として厚さ約 $800\text{ }\mu\text{m}$ のグラファイト板をカーボン系接着剤で固定した状態で、基板結晶1を図1に示した熱処理装置に配置した。マイクロパイプ欠陥閉塞熱処理工程として、雰囲気圧力が $6.67\times 10^4\text{ Pa}$ (500 Torr)、基板結晶1の温度が 2390°C 、炭化珪素4と基板結晶1の間の温度差が 10°C (炭化珪素4の温度 $=2400^\circ\text{C}$)となるようにして24時間の熱処理を行った。

【0078】このような工程を経て得られた基板結晶を(0001)面に平行に鏡面研磨した後、微分干渉顕微鏡と偏光顕微鏡を用いてその表面を詳細に観察した。その結果、マイクロパイプ欠陥6のうち開口部が結晶表面から露出していたものは全体の約20%であり、残り約80%は鏡面研磨面において開口部を持たない状態、すなわち完全に塞がれた状態になっていた。

【0079】このような工程で得られた基板結晶1を種結晶として、昇華法成長を行った。その後、得られた4H多形の単結晶インゴットから基板結晶2を切り出し、鏡面研磨した後、偏光顕微鏡を用いてマイクロパイプ欠陥密度を評価した。その結果、マイクロパイプ欠陥密度は、マイクロパイプ欠陥閉塞工程を施す前には約 50 cm^{-2} であったのが約 10 cm^{-2} に減少していた。

【0080】そして、上記全工程を再度繰り返した結果、最終的にマイクロパイプ欠陥密度が約 1 cm^{-2} まで減少した。

【0081】（実施例2）本実施例は、上記第2実施形態を具体的に実験したものである。

【0082】まず欠陥密度が約 50 cm^{-2} のマイクロパイプ欠陥6を有する厚さ $300\text{ }\mu\text{m}$ の4H多形のSiC単結晶で構成された基板結晶1を用意し、この基板結晶1のC面に被覆材料5として3C-SiCのエピタキシャル膜をCVD法を用いて約 $15\text{ }\mu\text{m}$ の厚さで形成した。

【0083】微分干渉顕微鏡、偏光顕微鏡、走査型電子顕微鏡を用いて観察したところ、マイクロパイプ欠陥6の開口部は3C-SiCのエピタキシャル膜によって隙間なく塞がれていた。なお、基板結晶1の表面は(0001)ジャスト面を用いており、3C-SiCのエピタキシャル膜は(111)面を成長面として成膜されている。

【0084】次に、上記被覆材料5の表面に表面保護部材として厚さ約 $800\text{ }\mu\text{m}$ のグラファイト板をカーボン系接着剤で固定した状態で、基板結晶1を図1に示した熱処理装置に配置した。マイクロパイプ欠陥閉塞熱処理

工程として、雰囲気圧力が $6.67 \times 10^4 \text{ Pa}$ 、基板結晶1の温度が 2230°C 、炭化珪素4と基板結晶1の間の温度差が 60°C （炭化珪素4の温度= 2290°C ）となるようにして24時間の熱処理を行った。

【0085】このような工程を経て得られた基板結晶を（0001）面に平行に鏡面研磨した後、微分干渉顕微鏡と偏光顕微鏡を用いてその表面を詳細に観察した。その結果、マイクロバンプ欠陥6のうち開口部が結晶表面に露出していたものは全体の約45%であり、残り約55%は鏡面研磨面において開口部を持たない状態、すな

わち完全に塞がれた状態になっていた。

【0086】このような工程で得られた基板結晶1を用いて、再度上記プロセスを繰り返した。その後、得られた基板結晶1を（0001）面に平行に鏡面研磨した後、微分干渉顕微鏡と偏光顕微鏡を用いてその表面を詳細に観察した。その結果、マイクロバンプ欠陥6のうち開口部が結晶表面から露出していたものは全体の約25%であり、残り約75%のものは鏡面研磨面において開口部を持たない状態、すなわち完全に塞がれた状態になっていた。

【0087】以上のプロセスをさらに2回繰り返すことによって、最終的なマイクロバンプ欠陥密度は約 5 cm^{-2} まで減少した。

【0088】（実施例3）本実施例は、実施例1に対して、図5に示す熱処理装置を用いた場合を示している。

【0089】まず欠陥密度が約 50 cm^{-2} のマイクロバンプ欠陥6を有する厚さ $300 \mu\text{m}$ の4H多形のSiC単結晶で構成された基板結晶1を用意し、この基板結晶1のC面に被覆材料5として3C-SiCのエピタキシャル膜をCVD法を用いて約 $15 \mu\text{m}$ の厚さで両面に形成した。

【0090】微分干渉顕微鏡、偏光顕微鏡、走査型電子顕微鏡を用いて観察したところ、マイクロバンプ欠陥6の開口部は3C-SiCのエピタキシャル膜によって隙間なく塞がれていた。なお、基板結晶1の表面は（0001）ジャスト面を用いており、3C-SiCのエピタキシャル膜は（111）面を成長面として成膜されている。

【0091】次に、基板結晶1を図5に示した熱処理装置に配置した。マイクロバンプ欠陥閉塞熱処理工程として、雰囲気圧力が $6.67 \times 10^4 \text{ Pa}$ （ 500 Torr ）、基板結晶1の温度が 2390°C 、炭化防止材料4としてのSiCとSiの混合粉末と基板結晶1の間の温度差が数 $^\circ\text{C}$ （炭化防止材料4の温度= 2400°C ）となるようにして24時間の熱処理を行った。

【0092】このような工程を経て得られた基板結晶を（0001）面に平行に鏡面研磨した後、微分干渉顕微鏡と偏光顕微鏡を用いてその表面を詳細に観察した。その結果、マイクロバンプ欠陥6のうち開口部が結晶表面から露出していたものは全体の約10%であり、残り約

90%は鏡面研磨面において開口部を持たない状態、すなわち完全に塞がれた状態になっていた。

【0093】このような工程で得られた基板結晶1を種結晶として、昇華法成長を行った。その後、得られた4H多形の単結晶インゴットから基板結晶2を切り出し、鏡面研磨した後、偏光顕微鏡を用いてマイクロバンプ欠陥密度を評価した。その結果、マイクロバンプ欠陥密度は、マイクロバンプ欠陥閉塞工程を施す前には約 50 cm^{-2} であったのが約 5 cm^{-2} に減少していた。

【0094】そして、上記全工程を再度繰り返した結果、最終的にマイクロバンプ欠陥密度が約 0.5 cm^{-2} まで減少した。

【0095】（実施例4）本実施例は、実施例1に対して被覆材料5の表面保護部材を用いなかった場合を示している。

【0096】まず欠陥密度が約 50 cm^{-2} のマイクロバンプ欠陥6を有する厚さ $300 \mu\text{m}$ の4H多形のSiC単結晶で構成された基板結晶1を用意し、この基板結晶1のC面に被覆材料5として3C-SiCのエピタキシャル膜をCVD法を用いて約 $15 \mu\text{m}$ の厚さで形成した。

【0097】微分干渉顕微鏡、偏光顕微鏡、走査型電子顕微鏡を用いて観察したところ、マイクロバンプ欠陥6の開口部は3C-SiCのエピタキシャル膜によって隙間なく塞がれていた。なお、基板結晶1の表面は（0001）ジャスト面を用いており、3C-SiCのエピタキシャル膜は（111）面を成長面として成膜されている。

【0098】次に、上記第1実施例で用いた被覆材料5の表面保護部材を用いずに、基板結晶1を図1に示した熱処理装置に配置した。マイクロバンプ欠陥閉塞熱処理工程として、雰囲気圧力が $6.67 \times 10^4 \text{ Pa}$ 、基板結晶1の温度が 2390°C 、炭化珪素4と基板結晶1の間の温度差が 10°C （炭化珪素4の温度= 2400°C ）となるようにして24時間の熱処理を行った。

【0099】このような工程を経て得られた基板結晶1を（0001）面に平行に鏡面研磨した後、微分干渉顕微鏡と偏光顕微鏡を用いてその表面を詳細に観察した。その結果、マイクロバンプ欠陥6のうち開口部が結晶表面から露出していたものは全体の約85%であり、残り約15%が鏡面研磨面において開口部を持たない状態、すなわち完全に塞がれた状態になっていた。

【0100】このような工程で得られた基板結晶1を種結晶として、昇華法成長を行った。その後、得られた4H多形の単結晶インゴットから基板結晶2を切り出し、鏡面研磨した後、偏光顕微鏡を用いてマイクロバンプ欠陥密度を評価した。その結果、マイクロバンプ欠陥密度は、マイクロバンプ欠陥閉塞工程を施す前には約 50 cm^{-2} であったのが約 45 cm^{-2} に減少しただけであった。

【0101】そして、上記全工程を再度、繰り返した結果、最終的にマイクロバンプ欠陥密度が約 40 cm^{-2} まで僅かに減少した。

【0102】このように、表面保護部材がない場合にもマイクロバンプ欠陥6が閉塞されるが、被覆材料5が熱エッチングされるため、表面保護部材がある場合と比べてマイクロバンプ欠陥6の閉塞が十分でないといえる。

【0103】（実施例5）本実施例は、上記実施形態における熱処理の温度条件よりも比較的低温で熱処理を行った場合である。

【0104】まず欠陥密度が約 50 cm^{-2} のマイクロバンプ欠陥6を有する厚さ $300\text{ }\mu\text{m}$ の4H多形のSiC単結晶で構成された基板結晶1を用意し、この基板結晶1のC面に被覆材料5として3C-SiCのエピタキシャル膜をCVD法を用いて約 $15\text{ }\mu\text{m}$ の厚さで形成した。

【0105】微分干渉顕微鏡、偏光顕微鏡、走査型電子顕微鏡を用いて観察したところ、マイクロバンプ欠陥6の開口部は3C-SiCエピタキシャル膜によって隙間なく塞がれていた。なお、基板結晶1の表面は（0001）ジャスト面を用いており、3C-SiCエピタキシャル膜は（111）面を成長面として成膜されている。

【0106】次に、上記被覆材料5の表面に厚さ約 $80\text{ }\mu\text{m}$ のグラフト板をカーボン系接着剤で固定した状態で、基板結晶1を図1に示した熱処理装置に配置した。マイクロバンプ欠陥閉塞熱処理工程として、雰囲気圧力が $6.65 \times 10^4\text{ Pa}$ 、基板結晶1の温度が 2100°C 、炭化珪素4と基板結晶1の間の温度差が 10°C となるようにして24時間の熱処理を行った。

【0107】このような工程を経て得られた基板結晶を（0001）面に平行に鏡面研磨した後、微分干渉顕微鏡と偏光顕微鏡を用いてその表面を詳細に観察した。その結果、マイクロバンプ欠陥6のうち開口部が結晶表面*

*から露出していたものは全体の約80%であり、残り約20%は鏡面研磨面において開口部を持たない状態、すなわち完全に塞がれた状態になっていた。

【0108】このような工程で得られた基板結晶1を種結晶として、昇華法成長を行った。その後、得られた4H多形の単結晶インゴットから基板結晶2を切り出し、鏡面研磨した後、偏光顕微鏡を用いてマイクロバンプ欠陥密度を評価した。その結果、マイクロバンプ欠陥密度は、マイクロバンプ欠陥閉塞工程を施す前には約 50 cm^{-2} であったのが約 40 cm^{-2} に減少していた。

【0109】そして、上記全工程を再度、繰り返した結果、最終的にマイクロバンプ欠陥密度が約 30 cm^{-2} まで減少した。

【0110】このように、上記温度条件より比較的低温であってもマイクロバンプ欠陥6を閉塞する効果が得られるが、第1実施形態で示した温度条件とするのが好適であるといえる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施形態を適用する熱処理装置内に基板結晶1を配置したときの図である。

【図2】図1に示す基板結晶1の近傍を拡大した図である。

【図3】マイクロバンプ欠陥閉塞工程としての熱処理を行った後における基板結晶1の様子を示す図である。

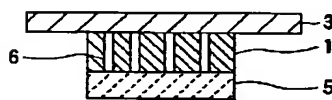
【図4】マイクロバンプ欠陥閉塞のメカニズムを説明するための図である。

【図5】炭化防止材料を配置した熱処理装置を説明するための図である。

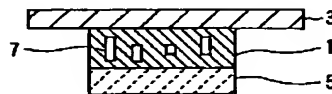
【符号の説明】

1…基板結晶、2…るつば、3…蓋体、4…炭化珪素原料、5…被覆材料、6…マイクロバンプ欠陥、7…閉塞孔。

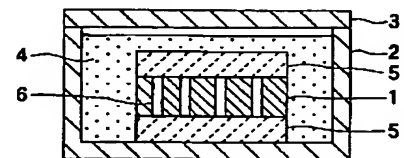
【図2】



【図3】

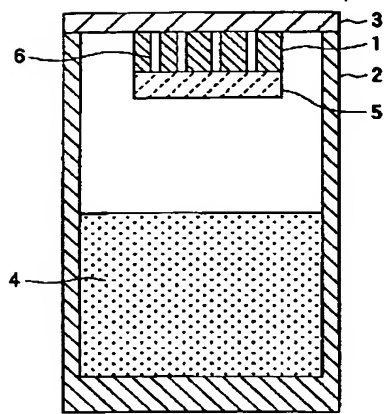


【図5】



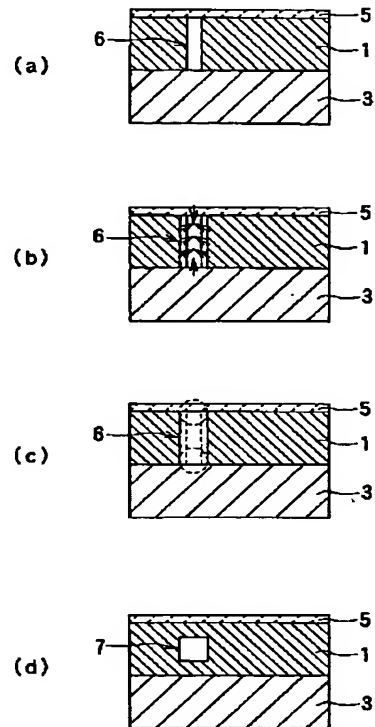
1: 炭化珪素単結晶 (基板結晶)
2: るつば
3: 蓋体
4: 炭化防止材料
5: 被覆材料
6: マイクロバンプ欠陥

【図1】



- 1: 炭化珪素単結晶 (基板結晶)
 2: るつぽ
 3: 露体
 4: 炭化珪素
 5: 被覆材料
 6: マイクロパイプ欠陥
 7: 閉塞孔

【図4】



フロントページの続き

(72)発明者 杉山 尚宏
 愛知県愛知郡長久手町大字長湫字横道41番
 地の1 株式会社豊田中央研究所内
 (72)発明者 谷 俊彦
 愛知県愛知郡長久手町大字長湫字横道41番
 地の1 株式会社豊田中央研究所内

(72)発明者 神谷 信雄
 愛知県愛知郡長久手町大字長湫字横道41番
 地の1 株式会社豊田中央研究所内
 (72)発明者 廣瀬 富佐雄
 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会
 社デンソー内

F ターム(参考) 4G077 AA10 BE08 DA01 DB01 ED01
 FE07 FE11 FE19
 5F045 AB06 AF02 AF12 BB12 HA16